

Понедельник, 22 апреля 2024 г.

1-е заседание Председатель – Двуреченский А.В.

- 9³⁰ – 9⁴⁵ Открытие конференции. Вступительное слово.
Академик РАН Латышев Александр Васильевич
- 9⁴⁵ – 10¹⁰ В.М. Ковалев
Фотоэлектрические эффекты в квантовых низкоразмерных структурах
- 10¹⁰ – 10³⁵ О.Е. Терещенко
Физика и технология гетероструктур применительно к твердотельной и вакуумной спинтронике и оптоэлектронике
- 10³⁵-11⁰⁰ В.П. Попов, М.С. Тарков, И.Е. Тыщенко, А.В. Мяконьких, К.В. Руденко
Нанометровые слои и структуры в кремниевой электронике
- 11⁰⁰ – 11²⁰ Кофе-брейк

2-е заседание Председатель – Милёхин А.Г.

- 11²⁰ – 11⁴⁵ М.В. Якушев, В.С. Варавин, В.В. Васильев, А.В. Вишняков, С.А. Дворецкий, А.В. Зверев, Ю.С. Макаров, Д.В. Марин, И.В. Марчишин, Н.Н. Михайлов, В.Г. Ремесник, С.В. Рыхлицкий, И.В. Сабинаина, Г.Ю. Сидоров, Ю.Г. Сидоров, В.А. Швец, А.В. Латышев
Десять лет технологии наногетероэпитаксиальных структур HgCdTe. Рост, квантовые эффекты и устройства
- 11⁴⁵ – 12¹⁰ А.И. Никифоров, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов, В.А. Тимофеев, К.Б. Фрицлер
Синтез наногетероструктур на основе соединений материалов 4 группы методом молекулярно-лучевой эпитаксии
- 12¹⁰ – 12³⁵ И.Б. Чистохин, М.А. Путято, М.О. Петрушков, Е.А. Емельянов, М.С. Аксенов, И.И. Рябцев, В.В. Преображенский, А.В. Латышев
Лавинный фотодиод на основе гетероструктуры InP/InGaAs/InP для счетчика фотонов в системах оптоволоконных квантовых коммуникаций
- 12³⁵ – 14³⁰ Обед

3-е заседание Председатель - Якушев М.В.

- 14³⁰ – 14⁵⁵ О.В. Наумова
Разработка элементов сенсорных систем кремниевой электроники и фотоники
- 14⁵⁵ – 15²⁰ Д.В. Щеглов, Л.И. Федина, Д.И. Рогило, Е.Е. Родякина, С.В. Ситников, А.К. Гутаковский, Е.В. Сысоев, А.В. Латышев
Атомно-силовая микроскопия в полупроводниковых нанотехнологиях: диагностика, метрология и литография
- 15²⁰-15⁴⁵ В.А. Ткаченко, А.С. Ярошевич, З.Д. Квон, Н.С. Кузьмин, О.А. Ткаченко, Д.Г. Бакшеев, И.В. Марчишин, А.К. Бакаров, Е.Е. Родякина, В.А. Антонов, В.П. Попов, А.В. Латышев
Высокая чувствительность мезоскопических наносистем к микроволнам
- 15⁴⁵ – 16⁰⁰ Н.Н. Михайлов, В.С. Варавин, А.В. Войцеховский, Д.И. Горн, С.А. Дворецкий, С.М. Дзядух, Р.В. Меньшиков, В.Г. Ремесник, Г.Ю. Сидоров, И.Н. Ужаков
Рост и характеристика pВп структур на основе Cd_xHg_{1-x}Te для фотоприемников среднего и дальнего ИК диапазонов
- 16⁰⁰ – 16²⁰ Кофе-брейк

4-е заседание Председатель –Терещенко О.Е.

- 16²⁰ – 16³⁵ В.А. Селезнев, В.С. Тумашев, Б.В. Волошин
Технологии формирования массивов наноструктур, основанные на методах штамповой литографии и атомно-слоевого осаждения пленок оксидов ванадия
- 16³⁵ – 16⁵⁰ А.Г. Милёхин, Н.Н. Курусь, Л.С. Басалаева, Е.Е. Родякина, И.А. Милёхин, А.В. Латышев
Ближнепольная оптическая спектроскопия полупроводниковых наноструктур

Вторник, 23 апреля 2024 г.

5-е заседание Председатель – Попов В.П.

- 9⁰⁰ – 9²⁵ А.В. Двуреченский, А.И. Якимов, А.Ф. Зиновьева, В.А. Володин, А.Г. Погосов, Н.П. Степина, В.А. Зиновьев, Ж.В. Смагина, В.В. Кириенко, Д. А. Похабов, А.А. Шевырин, Е.Ю. Жданов
Управление функциональными характеристиками компонент наноэлектроники и нанофотоники на основе полупроводниковых наноструктур
- 9²⁵ – 9⁵⁰ З.Д. Квон, Е.Б. Ольшанецкий, Н.Н. Михайлов, С.Д. Дворецкий
Новые квантовые эффекты в низкоразмерных электронных системах на основе HgTe
- 9⁵⁰-10¹⁵ И.И. Рябцев, И.И. Бетеров, Д.Б. Третьяков, Е.А. Якшина, В.М. Энтин, И.Н. Ашкарин
Применение высоковозбужденных ридберговских атомов в квантовых вычислениях и квантовых сенсорах
- 10¹⁵ – 10⁴⁰ К.С. Журавлев, А.И. Торопов, А.К. Бакаров, Д.В. Дмитриев, А.М. Гилинский, Д.В. Гуляев
Молекулярно-лучевая эпитаксия приборных гетероструктур
- 10⁴⁰ – 11⁰⁵ С.М. Чурилов
Развитие технологий и приборов оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазона в Филиале ИФП СО РАН «КТИПМ»
- 11⁰⁵ – 11³⁰ Кофе-брейк

6-е заседание Председатель – Квон З.Д.

- 11³⁰ – 11⁴⁵ М.С. Аксенов, К.С. Журавлев, В.В. Преображенский, И.Б. Чистохин, А.М. Гилинский, Д.В. Дмитриев, М.А. Путьято, И.Ю. Гензе, М.О. Петрушков, Е.А. Емельянов, Е.Р. Закиров, М.А. Суханов
Разработка основ технологии создания фотоприемных устройств на основе полупроводников Al_2O_3
- 11⁴⁵ – 12⁰⁰ Д.С. Милахин, Т.В. Малин, В.Г. Мансуров, Д.Ю. Протасов, И.В. Осинных, Я.Е. Майдэбура, Д.Д. Башкатов
Аммиачная молекулярно-лучевая эпитаксия GaN гетероструктур на подложках кремния для силовых и СВЧ транзисторов
- 12¹⁵ – 12³⁰ A.S. Esbergenova, U.A. Shaislamov
Effect of Fe and Cu impurity induced donor and acceptor levels on the photocatalytic activity of ZnO.

12⁴⁵ – 13⁰⁰

Д.А. Колосовский, Д.В. Бекреева, Т.М. Залялов, С.А. Пономарев, Ю.Г. Шухов, А.А. Морозов,
С.В. Старинский
Синтез пленок золота на подложках кремния и кварца наносекундными лазерными импульсами.

13⁰⁰ – 13¹⁵

В.В. Дирко, О.И. Кукенов, К.А. Лозовой, А.П. Коханенко
Влияние температуры подложки на процессы эпитаксиального роста Ge на Si (001).

13¹⁵ – 13³⁰

Закрытие конференции